Ru⁴⁺置換ガーネットの磁気光学効果

Magneto-optical Effect in Ru⁴⁺-substituted Garnets

竹内 敦子, 坂井 留利子, 安藤 功兒*, 品川 公成

東邦大学理学部, 千葉県船橋市三山 2-2-1 (〒274-8510)

*電子技術総合研究所, 茨城県つくば市梅園 1-1-4 (〒305-8568)

A. Takeuchi, R. Sakai, K. Ando*, and K. Shinagawa

Department of Physics, Toho University, 2-2-1 Miyama, Funabashi-shi, Chiba 274-8510

*Electrotechnical Laboratory, Umezono 1-1-4, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8568

(1999年10月26日受理, 2000年1月25日採録)

Faraday rotation (FR) in a Ru⁴⁺-substituted magnetic garnet was measured in the visible to near ultraviolet wavelength region. An FR contribution due to Ru⁴⁺ ions was observed at around 2.8 eV and increased with increasing temperature. On the basis of the energies of charge transfer (CT) transitions in a (Ru⁴⁺O₆)⁸⁻ cluster calculated by an unrestricted SCF-SW-X α method and the analysis of magnetic circular dichroism spectra measured in a Ru⁴⁺-substituted gadolinium gallium garnet, the transition at around 2.8 eV is assigned to the allowed CT transition of the lowest energy from O²⁻ 2p to Ru⁴⁺ 4d orbitals, that is, the t_{1u} (π) $\rightarrow$ t_{2g}* transition. Furthermore, the temperature dependences of FR spectra are explained by a thermally induced FR from the first excited state of Ru⁴⁺.

Key words: magneto-optical effect, Ru⁴⁺-substituted garnet, charge transfer transition, SW-X α method

1. はじめに

磁性ガーネットの構成イオンの一部を Bi³⁺, Co²⁺, Ce³⁺ などで置換すると、ファラデー回転(FR)が増大することが知られている¹⁾。最近、我々のグループでは磁性ガーネットの Fe³⁺の一部を Rh⁴⁺(4d)⁵, Ir⁴⁺(5d)⁵で置換することによって、可視から近赤外領域においてFRが増大することを見出した^{2), 3)}。このFRの増大はO²⁻の2p軌道から4dあるいは5d軌道への電荷移動遷移(CT遷移)に起因すると解釈されている²⁾。今回我々は、Ru⁴⁺(4d)⁴によるFRの寄与を明らかにすることを目的とし、Ru⁴⁺置換 YIG の FR と Ru⁴⁺置換 GGG の磁気円二色性(MCD)スペクトルを測定し、非制限 SCF-SW-X α 法による電子状態の計算結果に基づいて解析を行った⁴⁾。

2. 実験方法

試料は、フラックスに PbO, B₂O₃ を用い、LPE 法によって GGG 基板(111)面に育成した (Y_{3-x}Ca_x)(Fe_{5-x}Ru_x)O₁₂ (x = 0, 0.06) 及び (Gd_{3-x}Ca_x)(Ga_{5-x}Ru_x)O₁₂ (x = 0.04) 単結晶膜である⁵⁾。その際、Fe³⁺及びGa³⁺をRu⁴⁺で置換するための電荷補償イオンとしてCa²⁺を用いた。膜の組成は、ICPS(Inductively Coupled Plasma Spectroscopy)法で、格子定数はX線回折を用い(888)のピークから見積もった。膜厚はYIGの平均屈折率2.15を用い、光吸収スペクトルの干渉縞により求めた。光吸収スペクトルは300 Kにおいてのみ、FRとMCDはそれぞれ12 kOe, 10 kOeの磁場を印加し、60 Kから300 Kの温度において測定した。

3. 実験結果

3.1 試料の評価

Table 1に今回膜育成に用いたメルトの組成を示した。Table 2に膜の育成温度(T_g)、dipping time(D. T.)、膜厚、格子定数を、また、膜の組成をTable 3に示す。Ruの置換量は0.1/f. u.以下と微量であるが、Caの量は同程度もしくはそれ以上であるので、膜中のRuは4価であると考えられる。更に、不純物であるPb, Ptは試料作製の際にフラックス及び坩堝から混入したと思われるが、微量であり、その影響は無視できる程度である。

3.2 Ru⁴⁺置換 YIG の FR スペクトル

Fig. 1に60 K~300 Kで測定した(Y_{3-x}Ca_x)(Fe_{5-x}Ru_x)O₁₂ (x = 0, 0.06)のFRスペクトルを示す。いずれも、2.8 eV付近に高温になると低エネルギー側にシフトする大きなFRが観測された。また、Ru⁴⁺置換膜(x=0.06)のFRスペクトルでは、YIG膜(x=0)に比べて2.8 eV付近のピークが高温で急激に減少していることが分かる。なお、YIG膜の60 Kにおける2.8 eV付近のピークは、この領域での吸収の増加により測定できず、YIGの部分格子の磁化の温度変化から見積もった⁶⁾。このFRの起源を明らかにするために、60 K~300 Kにおいて(Gd_{3-x}Ca_x)(Ga_{5-x}Ru_x)O₁₂ (x = 0.04)の光吸収スペクトルおよびMCDスペクトルを測定した。

3.3 Ru⁴⁺置換 GGG の MCD スペクトル

Fig. 2に光吸収とMCDスペクトルの測定結果を示す。光吸収スペクトルでは、3.5 eV付近にピークをもち低エネルギー側に肩をもつスペクトルが観測された。また、MCDスペクトルでは複雑な構造が観測され、その構造は低温になるに従って顕著になる様子が観察された。

Table 1. Melt compositions for (a) (Y_{3-x}Ca_x)(Fe_{5-x}Ru_x)O₁₂, and (b) (Gd_{3-x}Ca_x)(Ga_{5-x}Ru_x)O₁₂ films.

mol% X	Y ₂ O ₃	CaCO ₃	Fe ₂ O ₃	RuO ₂	PbO	B ₂ O ₃
	(a) 0	0.30	-	12.70	-	77.33
(a) 0.06	0.61	0.23	13.94	0.56	75.25	9.41
	Gd ₂ O ₃	CaCO ₃	Ga ₂ O ₃	RuO ₂	PbO	B ₂ O ₃
(b) 0.04	0.79	0.14	14.42	0.29	74.99	9.37

Table 2. Growth condition, film thickness d and lattice constant a for (a) $(Y_{3-x}Ca_x)(Fe_{5-x}Ru_x)O_{12}$, and (b) $(Gd_{3-x}Ca_x)(Ga_{5-x}Ru_x)O_{12}$ films.

X	Tg (°C)	D.T. (min)	d (μm)	a (Å)
(a) 0	990	0.75	1.10	12.376
(a) 0.06	940	10	0.77	12.384
(b) 0.04	930	30	3.02	12.384

Table 3. Compositions of (a) $(Y_{3-x}Ca_x)(Fe_{5-x}Ru_x)O_{12}$, and (b) $(Gd_{3-x}Ca_x)(Ga_{5-x}Ru_x)O_{12}$ films.

X	Y	Ca	Pb	Fe	Ru	Pt
(a) 0	3.00	-	0.00	4.99	-	0.01
(a) 0.06	2.92	0.07	0.01	4.93	0.06	0.01
X	Gd	Ca	Pb	Ga	Ru	Pt
(b) 0.04	2.93	0.07	0.00	4.95	0.04	0.01

Fig. 1 FR spectra of $(Y_{3-x}Ca_x)(Fe_{5-x}Ru_x)O_{12}$, (a) $x = 0$, (b) $x = 0.06$ films measured at temperatures between 60 K and 300 K.

Fig. 2 Absorption and MCD spectra of $(Gd_{3-x}Ca_x)(Ga_{5-x}Ru_x)O_{12}$ ($x = 0.04$) film.

4. 計算および解析結果

4.1 $(Ru^{4+}O^{2-})^8$ cluster の電子状態

$(Gd_{3-x}Ca_x)(Ga_{5-x}Ru_x)O_{12}$ ($x = 0.04$) の MCD スペクトルの解析には、非制限 SCF-SW-X α 法によって計算した $(Ru^{4+}O^{2-})^8$ cluster の電子状態と遷移エネルギーを用いた⁴⁾。計算に使用したパラメーターとしては、Ru-O 間距離を GGG の octahedral site における Ga-O 間の平均の距離 3.787 a.u. とし、Ru, O のイオン半径をそれぞれ 1.787, 2.00 a.u. (1 a.u.=0.5292 Å)、交換パラメーター α をそれぞれ 0.7030, 0.7445 とした⁴⁾。Fig. 3 に計算した $(Ru^{4+}O^{2-})^8$ cluster の一電子エネルギー準位と電子状態を示す。ここで、 t_{2g}^* と e_g^* は Ru^{4+} の 4d-like な準位、その他は O^{2-} の 2p-like な準位である。基底状態では、up-spin 電子は t_{2g}^* までの準位全てを占有するが、down-spin 電子は t_{2g}^* 軌道を 1 つだけ占有する低スピン状態となっている。従って、ホールのある t_{2g}^* 軌道に対し、 O^{2-} の 2p-like な t_{1u} 及び t_{2u} から 3 つの CT 遷移が許容される。それぞれの CT 遷移の遷移エネルギーの計算値を Fig. 3 中に示した。

Fig. 3 One-electron energy levels and 4d electron configuration in the ground state of a $(Ru^{4+}O^{2-})^8$ cluster.

4.2 MCD スペクトルの解析

(Ru⁴⁺0²⁺)⁸⁻ cluster の基底状態は、 $|\alpha t_{2g}^{*4} {}^3T_{1g} \gamma\rangle$ で与えられる。ここで、 α は電子が占有する全ての電子配置を意味する。スピン軌道相互作用(S.O.)を考慮すると、 ${}^3T_{1g}$ は $T_{1g} \times T_{1g} = A_{1g}, E_g, T_{1g}, T_{2g}$ に分裂する。スピン軌道相互作用係数 λ は、Ru⁴⁺ の 4d 電子のスピン軌道相互作用定数 ζ_{4d} を用いて、 $\lambda = \zeta_{4d} / 2$ で与えられ、正であるので、基底状態は縮退がない A_{1g} となる。従って、電気双極子遷移を想定すると、選択則から励起状態の対称性は T_{1u} でなければならない。電子間のクーロン相互作用を考慮すると、 $t_{1u} \rightarrow t_{2g}^*$ CT 遷移の励起状態は、 $|\alpha' t_{2g}^{*5} ({}^2T_{2g}) t_{1u}^{*5} ({}^2T_{1u}), {}^3\Gamma \gamma\rangle$, $\Gamma = T_{2g} \times T_{1u} = A_{2u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}, t_{2u} \rightarrow t_{2g}^*$ CT 遷移では、 $|\alpha'' t_{2g}^{*5} ({}^2T_{2g}) t_{2u}^{*5} ({}^2T_{2u}), {}^3\Gamma' \gamma'\rangle$, $\Gamma' = T_{2g} \times T_{2u} = A_{1u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}$ で与えられる。更に、スピン軌道相互作用を考慮することにより、励起状態は $\Gamma \times T_{1g}$ あるいは $\Gamma' \times T_{1g}$ の状態に分裂する。対称性を考慮すると、 $|e\rangle = |\alpha' [t_{2g}^{*5} ({}^2T_{2g}) t_{1u}^{*5} ({}^2T_{1u}), {}^3\Gamma] T_{1u} \gamma\rangle$, $\Gamma = E_u, T_{1u}, T_{2u}$, $|e'\rangle = |\alpha'' [t_{2g}^{*5} ({}^2T_{2g}) t_{2u}^{*5} ({}^2T_{2u}), {}^3\Gamma'] T_{1u} \gamma'\rangle$, $\Gamma = A_{1u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}$ が許容される励起状態となる。励起状態 T_{1u} は atomic な $P(L=1)$ state と等価であるので、外部磁場によって $L_z = -1, 0, 1$ に分裂する。Fig. 4 の挿入図に $A_{1g} \rightarrow T_{1u}$ 遷移と左右円偏光に対する選択則の概略図を示す。この時、外部磁場 H_{ext} による励起状態の分裂 Δ によって MCD を生じ、MCD スペクトル ϕ_F は次の分散式で与えられる⁷⁾。

$$\phi_F(\omega) = C \cdot \frac{\gamma(\omega_0 - \omega)}{\{(\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2\}^2} \quad [\text{deg/cm}] \quad (1)$$

ここで、 C は Ru⁴⁺ のイオン数 N 、遷移の振動子強度 f_{ij} 、励起状態の分裂エネルギー Δ に比例する定数で、 ω_0 は中心周波数、 γ は遷移の半値幅である。基底状態には縮退がないので、Fig. 2 に見られる MCD スペクトルの温度依存性は、 γ の温度変化に起因している。(1) 式を用いて計算した 60 K における MCD スペクトルを Fig. 4(1) に、その温度依存性を Fig. 4(2) に示す。計算に用いたパラメータを Table 4 にまとめた。実験で観測された MCD スペクトルは Fig. 4(1) 中に示す、A), B), C) の 3 つの分散の重ね合わせで良く表される事が分かる。また、それぞれの中心周波数は (Ru⁴⁺0²⁺)⁸⁻ cluster の電子状態の計算から求めた遷移エネルギー (Fig. 3) に良く対応している。また、Fig. 4(2) に示したように、MCD スペクトルの温度変化も γ の温度変化を考慮して、良く説明できることが分かる。以上の解析結果から、2.8 eV 付近に Ru⁴⁺ に関連した CT 遷移 $t_{1u}(\pi) \rightarrow t_{2g}^*$ が現れることが分かった。

Table 4. Parameters used in the calculation of MCD spectra.

	ω_0 eV (cm ⁻¹)	C ($\times 10^9$)	γ : 60K eV (cm ⁻¹)	γ : 180K	γ : 300K
A)	2.78 (22420)	0.5	0.310 (2500)	0.620 (5000)	0.868 (7000)
B)	3.42 (27590)	0.7	0.248 (2000)	0.310 (2500)	0.372 (3000)
C)	3.80 (30650)	-4.5	0.496 (4000)	0.645 (5200)	0.806 (6500)

Fig. 4 MCD spectra of (Gd_{3-x}Ca_x)(Ga_{5-x}Ru_x)O₁₂ (x = 0.04) calculated from eq. (1).

4.3 FR スペクトル

前節の解析から Fig. 2 に示した (Y_{3-x}Ca_x)(Fe_{5-x}Ru_x)O₁₂ (x = 0, 0.06) の FR スペクトルにおいて、2.8 eV 付近に $t_{1u}(\pi) \rightarrow t_{2g}^*$ CT 遷移による Ru⁴⁺ の寄与が現れていることが予想される。そこで、2.8 eV 付近のピークの大きさを測定温度に対してプロットしたものを Fig. 5 に示した。また、FR は一般に、部分格子磁化に比例するので、分子場近似を用いて部分格子磁化の温度変化を計算した。その結果を Fig. 6 に示す。Ru⁴⁺ の寄与が、単に YIG 中の Fe の減少に依るのであれば、2.8 eV 付近のピークは Fig. 6 に示す磁化の温度変化の実線と破線との差程度の温度変化が期待されるので⁸⁾、YIG のピークの温度変化とあまり差がないと考えられる。しかし、Fig. 5 に示したように、Ru⁴⁺ の寄与が高温ほど著しく大きくなっていることから、Ru⁴⁺ による寄与が現れていると考えられる。前述したように、(Ru⁴⁺0²⁺)⁸⁻ cluster の基底状態は A_{1g} であり、縮退がない。そのため励起状態に対する分子場の影響を無視する⁸⁾ と、低温においては FR は生じない。しかし、有限温度においては、内部磁場 H_{int} によって分裂した第一励起状態 T_{1g} からの遷移が許される可能性がある。この遷移では、Fig. 7 に示したように左右円偏光の選択則の違いから FR が生じる。このとき、ファラデー回転 θ_F は、

$$\theta_F \approx \exp(-\lambda/kT) \cdot m(T) \cdot F(\omega, \omega_0) \quad (2)$$

と表される⁸⁾。ここで、 λ はS.O.係数、 k はBoltzmann定数、 m は内部磁場の大きさ、 F は分散式であり、指数因子は励起状態 T_{ig} の占有確率を意味する。

Fig. 5 Temperature dependences of FR peaks at around 2.8 eV of $(Y_{3-x}Ca_x)(Fe_{5-x}Ru_x)O_{12}$ ($x = 0, 0.06$) films.

Fig. 6 Temperature dependences of total, d-, and a-sublattice magnetizations calculated by molecular field approximation.

Fig. 7 $\ln [\theta_F(YIG) - \theta_F(Ru^{4+}:YIG)]$ of FRS peak values at around 2.8 eV.

そこで、 $\theta_F(YIG) - \theta_F(Ru^{4+}:YIG)$ の自然対数を取り、 $1/T$ に対してプロットしたものをFig. 7に示した。その結果、ほぼ直線となり、内部磁場 $m(T)$ の温度変化(Fig. 6)が無視できれば、(2)式で表されるような温度変化を示すことが分かった。また、その傾きから λ を求めると、 $\lambda \sim 450$ Kとなった。すなわち、 Ru^{4+} 置換 YIG の 2.8 eV 付近の FR は、 Ru^{4+} の基底状態に縮退がないため第一励起状態からの熱誘起型の FR であると考えられる。なお、 $Ru^{4+}(4d^4)$ のS.O.係数 λ は、 Ru^{4+} イオンのS.O.定数の計算値 $\lambda_{4d} = 1940$ Kを使うと、 $\lambda \sim 970$ Kになる⁹⁾。この値は、FRの解析から求められた $\lambda \sim 450$ Kに比べて、2倍程度大きな値をもつ。

5. まとめ

Ru^{4+} 置換 YIG における $Ru^{4+}(4d^4)$ によるFRの寄与を明らかにするため、そのFRおよび Ru^{4+} 置換GGGのMCDスペクトルを測定し、非制限SCF-SW-X α 法による電子状態の計算結果に基づいて解析を行った結果、以下のことが明らかになった。

- (1) Ru^{4+} 置換GGGのMCDスペクトルの測定および解析から、そのスペクトルは2.78, 3.42, 3.80 eVに中心をもつ3つの分散型スペクトルの重ね合わせからなることが分かった。また、
- (2) それら3つの分散の中心は、非制限SCF-SW-X α 法により求めた 0^2 の2pから Ru^{4+} の4dへのCT遷移の遷移エネルギー2.75, 3.35, 4.12 eVに良く一致することから、それぞれを $t_{1u}(\pi) \rightarrow t_{2g}^*$, $t_{2u} \rightarrow t_{2g}^*$ および $t_{1u}(\sigma) \rightarrow t_{2g}^*$ CT遷移に同定した。
- (3) Ru^{4+} 置換YIGのFRスペクトルにおいて、2.8 eV付近に、高温で大きくなる、FRが観測された。その寄与を $t_{1u}(\pi) \rightarrow t_{2g}^*$ CT遷移に依るFRに同定した。
- (4) このFRスペクトルは、 Ru^{4+} の基底状態に縮退がないため、第一励起状態からの熱誘起型FRの可能性を示唆した。

文 献

- (1) A. K. Zvezdin and V. A. Kotov: Modern Magneto-optics and Magneto-optical Materials, p. 186 (Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 1997).
- (2) K. Shinagawa, E. Tobita, K. Ando, T. Saito and T. Tsushima: *J. Appl. Phys.* **81**, 1368 (1997).
- (3) E. Tobita, K. Shinagawa, T. Saito and T. Tsushima: *J. Magn. Soc. Jpn.* **20** (Suppl. S1) 439 (1996).
- (4) J. C. Slater: Quantum Theory of Molecules and Solids, Vol. 4 (McGraw-Hill, New York, 1974).
- (5) T. Hibiya: *Current Topics in Crystal Growth Research* **3** 199 (1997).
- (6) G. F. Dionne: *J. Appl. Phys.* **41**, 4878, (1970).
- (7) 佐藤勝昭: 光と磁気, p. 37 (朝倉書店, 東京, 1988).
- (8) K. Shinagawa, Z. Simsa, T. Saito, and T. Tsushima: *Jpn. J. Appl. Phys.*, **36**, 213 (1997).
- (9) T. M. Dunn: *Trans. Faraday Soc.* **57**, 1441, (1961).